

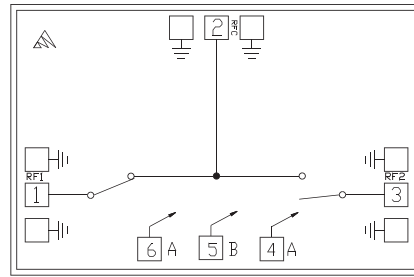
性能特点

- 工作频段: DC~12GHz
- 隔离度: 37dB@12GHz
- 插入损耗: 0.9dB@12GHz;

反射式设计

- 芯片尺寸: 1.16x0.78 x 0.1 mm

功能框图



概述

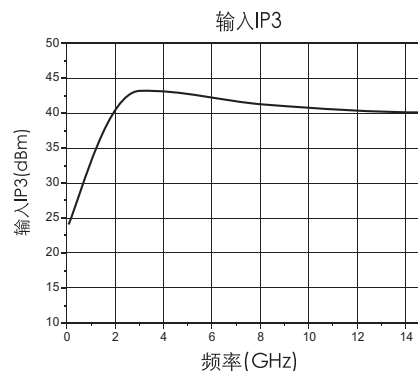
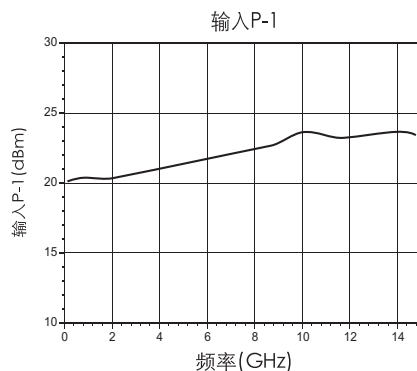
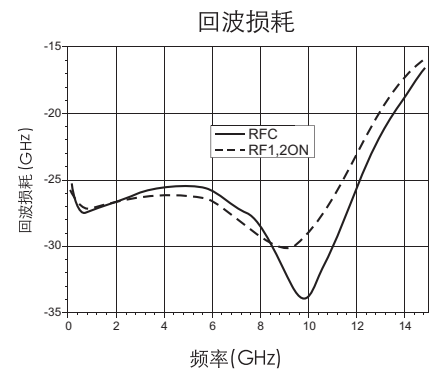
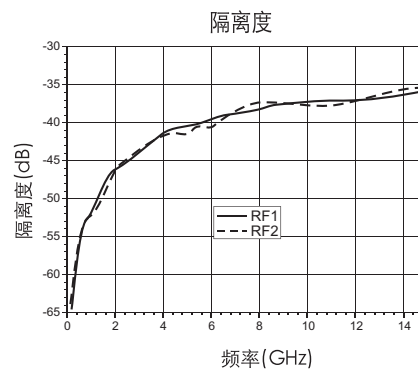
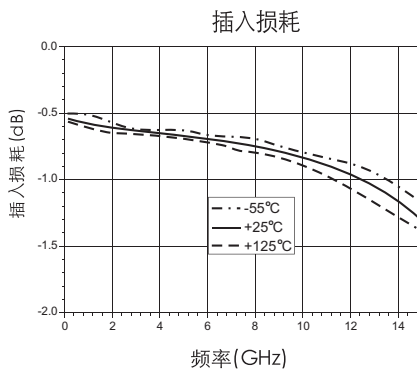
BW118是一款反射式砷化镓pHEMT单刀双掷开关芯片，工作频率覆盖DC~12GHz。该开关芯片在整个工作频段能够提供小于1.0dB的插入损耗和大于36dB的隔离度。采用0/-5V逻辑控制，不需要外接电源偏置，没有功率消耗。非常适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块以及低功耗系统。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

电性能表(T_A =+25℃, 0/-5V控制, 50Ω system)

参数名称	测试 频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	DC - 12 GHz	-	0.7	1.1	dB
隔离度	DC - 12 GHz	32	37	-	dB
回波损耗 RFC (ON)	DC - 12 GHz	21	25	-	dB
回波损耗 RF1 , RF2 (OFF)	DC - 12 GHz	20	23	-	dB
输入 P-1	0.5 - 12 GHz	-	23	-	dBm
输入 IP3	0.5 - 12 GHz	-	40	-	dBm
开关时间	-	-	5	-	ns

测试曲线(射频端口使用两根Φ25um长400um的键合线)



控制电压

状态	偏置条件
低	0 ~ -0.2V
高	-3 ~ -7V

真值表

控制输入		通断状态	
A	B	RFC-RF1	RFC-RF2
高	低	ON	OFF
低	高	OFF	ON

BW118型GaAs单片集成反射式SPDT开关

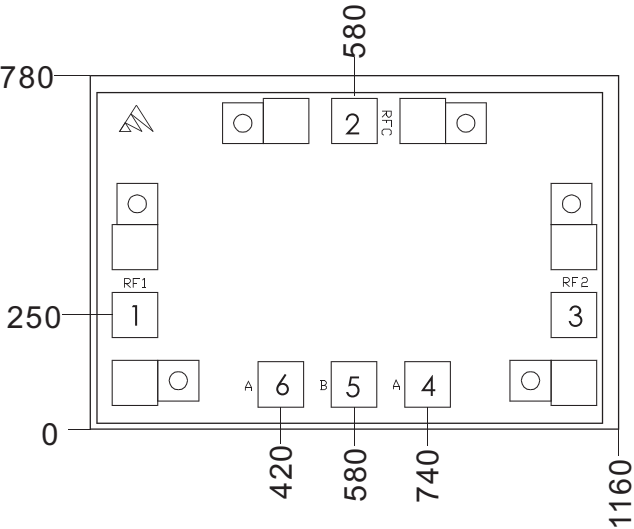
极限参数

射频输入功率 (Vctl=-5V)	+27dBm
控制电压范围 (A, B)	+0.5~-7.5V
结温 (°C)	175
储存温度 (°C)	-65~+150
工作温度 (°C)	-55~+125
静电防护等级 (HBM)	Class 1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

外形尺寸



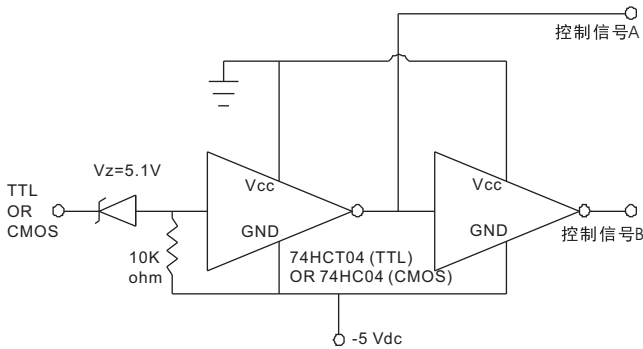
说明:

1. 单位: 微米
2. 芯片背面镀金
3. 芯片背面接地
4. 键合压点镀金, 压点尺寸:100umx100um;
5. 不能在通孔上进行键合
6. 外形尺寸公差: ±50um

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
2	RFC	RF输入端口, 阻抗50ohm, 射频通路不是0V, 需外接隔直电容
1,3	RF1, RF2	RF输出端口, 阻抗50ohm, 射频通路不是0V, 需外接隔直电容
5	CTRLB	控制端口
4,6	CTRLA	控制端口
-	GND	芯片背面必须接地

推荐驱动电路



应用信息

- 装配图 (射频端口使用两根Φ25um长400um的键合线)

